· 100 日本国特許庁(JP) ① 特許出願公開

平2-181701 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)7月16日

G 02 B 1/10

8106-2H Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称

反射防止膜の製造方法

の特 頭 平1-1765

顧 昭64(1989)1月7日 ❷出

@発 明 者 ⑫発 明 者 人 司 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内

日東電工株式会社 ⑪出 願 人

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

四代 理 人

弁理士 祢冝元 邦夫

1.発明の名称

反射防止膜の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 電子ビーム型真空蒸着装置において、屈折率 が 1.50~1.80のプラスチツク透明基材の表面 に、この基材の表面倒から順次、蒸着材料の加熱 激となる電子ピームの投入パワーを変えることに よつて、同種の無機質酸化物材料により、第1層 と第2層との屈折率差 (n₂ - n₁)が0.05≦ ($n_z - n_1 \le 0.20$ (ただし、 $n_z > n_1$) とな るように、屈折率n, が1.95≤n, ≤2.10の 第1層と屈折率 n . が 2.00≤ n . ≤ 2.20の第 2 酒とからなる高屈折率薄膜層を形成し、さらに その上に上記の2層とは別種の無機質酸化物材料 により屈折率 n a が l. 4 5 ≤ n a ≤ l. 4 7 の第 3 層からなる低屈折率薄膜層を形成することにより、 上記第1層、第2層および第3層の配折率 n., n z, n z に対応する光学的膜厚 d ı, d z, d s が n ı $d_1 - n_2 d_2 - n_3 d_3 - \lambda_0 / 4 (\pm \lambda_0 /$

20) (ただし、 /。は設計波長で、 480 nm ≤ A。 ≤ 5 6 0 n m) である反射防止膜を得るこ とを特徴とする反射防止膜の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明はプラスチック透明基材の表面に高屈 折事強膜層と低屈折率薄膜層とを組み合わせて形 成させた反射防止膜の製造方法に関する。

(従来の技術)

反射防止膜としては、従来より、プラスチツク 透明基材を用いて、この基材の表面に基材の屈折 率より大きい屈折率を有する高屈折率弾膜層を第 1 層として形成し、さらにこの上に基材の屈折率 より小さい屈折率を有する低屈折率削膜層を第2 層として形成した2層膜からなるものがすぐれた 反射防止効果を示すものとして知られている。

この2層膜において、第2層を構成する低屈折 率材料としては、安定な無機質酸化物の中で最も 低い屈折率を持つMgFェが最適であるが、基材 としてプラスチツクを用いる場合その耐熱性から

低温で熟 を行う必要があるため、この場合硬度 不足のMgF。 薄膜しか得られず、耐久性のある 反射防止膜は得られない。

一方、この出願人は、耐久性のあるSiOュ 薄膜を最外層として、上記従来の2層膜とほぼ同等の反射防止効果が得られる3層膜からなる反射防止膜を提案し、特願昭63-86497号として既に出願している。

この3層膜からなる先行発明に係る反射防止膜は、プラスチック透明基材として屈折率が1.50~1.80の範囲のものを用い、この基材を2.10のから順次、屈折率n,が1.95をn。公2.20である無機質を必要をである第2層とを、上記第1層と数をである第2層とを、上記第1層となるをである第2層とない。この両層により高屈折率では関係を形成である。公1.47である無機質酸化物薄膜が1.45、1、公1.47である無機質酸化物薄膜が1.45の第3層、すなわち低屈折率 で 膜層を形成して、

より、第1 暦として屈折率 n , = 2.0 の 2 r O 。 なる 薄膜を、第2 暦として屈折率 n 。 = 2.1 の 2 r O 定

。薄膜を形成するといつた方法である。 (発明が解決しようとする課題)

この発明は、上記の先行発明の問題点に鑑み、 3 層膜における高屈折率薄膜層を構成させるため の第 1 および第 2 の層を、同種の無機質酸化物材 料を用いて、その屈折率差が既述のとおりとなる ように、前記した酸素ガス導入量の偶整法とは異 このため、上記の先行発明では、蒸着材料に金属ターゲットを用いて、酸素ガスを導入しながらの反応性スパッタリングにより無機質を必えることによって無機質酸化物薄膜の酸化度を調整し、これによって屈折率の異なる前記第1 および第2の層を形成するという方法につき 貫及している。たとえば、2 r ターゲットを用い、酸素ガスを導入した反応性スパッタリングにより、2 r O ェ 溶膜を形成するに際し、その酸化度を変えることに

なる特定の手法で形成することにより、品質の安 定した反射防止膜を有利に得る方法を提供するこ とを目的としている。

[課題を解決するための手段]

本発明者らは、上記の目的を達成するために鋭意検討した結果、電子ピーム型真空落着装置を使い、無機質酸化物材料を蒸発させるための電子ピームの投入パワーを変えることにより、同種の無機質酸化物材料から異なる屈折率の無機質酸化物溶膜が得られることを知り、この方法を前記した第1および第2の層の形成に応用することによって所望の屈折率が安定して得られるものであることを見い出し、この発明を完成するに至つた。

すなわち、この発明は、電子ピーム型真空蒸巻装置において、屈折率が1.50~1.80のプラスチック透明基材の表面に、この基材の表面例から取次、落着材料の加熱源となる電子ピームの投入パワーを変えることによつて、同種の無機質酸化物材料により、第1層と第2層との屈折率差(ng-ng)が0.05≤(ng-ng)≤0.20(ただ

(発明の構成・作用)

以下、この発明の反射防止膜の製造方法を図面 に基づき説明する。

第1図は、この発明の製造方法に用いる電子ビーム型裏空蒸着装置の概略構成を示すもので、1は真空槽、2は蒸着材料、3は投入パワーのコントロールが可能に構成された上記材料2の加熱源

の材料からなる屈折率 n_2 が $2.00 \le n_2 \le 2.2$ 0 の第 2 層 1.3 とで構成されて、かつこれら両層の屈折率の差が $0.05 \le (n_2 - n_1) \le 0.20$ となる高屈折率薄膜層が形成され、さらにこの上に低屈折率薄膜層として屈折率 n_3 が $1.45 \le n_2 \le 1.47$ の第 3 層 1.4 が形成されたこの発明に係る反射防止膜が連続的に製造される。

この反射防止膜は、各層の屈折率 n 1, n 1, n 1 に対応する光学的膜厚 d 1, d 2, d 2 が、設計被長 λ。が 4 8 0 n m 5 λ。 5 6 0 n m の範囲において、 λ。 / 4 (± λ。 / 2 0) として設定されたものであつて、上記第1 および第2 の層が電子ピームの投入パワーの違いによつて上述したとおりの所望の屈折率差に正確に設定されていることにより、 3 層膜として期待されるすぐれた反射防止効果を発揮する。

この発明の上記方法において、用いるプラスチック透明基材11としては、ポリメチルメタクリレート、ポリカーポネート、ポリスチレン、ポリフエニレンサルフアイド、ポリエチレンテレフタ

となる電子ビーム銃、4 は巻き出しプラスチックフィルムロール、5 は巻き取りプラスチックフィルムロール、6 は蒸着用ロール、7~10 はピンチロールである。

この方法により、第2図に示すように、屈折率 が1.50~1.80のプラスチック透明基材11の 表面に、屈折率 n: が1.95 $\leq n$: ≤ 2.10 の無 機質酸化物薄膜からなる第1層12とこれと同種

第1層12および第2層13の形成に際し、電子ピーム銃3の投入パワーを具体的にどの程度にするかは、蒸着材料や蒸着速度、真空度などの蒸着条件により相違するから、一概には決められない。一例として、蒸着材料として酸化ジルコニウムを用いる場合、電子ピームの投入パワーをたとえば第1層12の形成時で250~320mA、10kV、第2層13の形成時で330~400

にすぐれる酸化ケイ素(SlOz)が最適である。

m A. 10 k V となるようにするのがよい。この ときの真空度は 1 × 10⁻¹~9×10⁻⁴Torr、 蒸着速度は 0.5 ~ 2 m / 分程度である。

(発明の効果)

以上のように、恋者材料の方法では、恋者材料の加熱源となる電子ピームの投入パワーを変えるだけで、同種の無機質酸化物材料から屈折率薄膜なる第1および第2の層よりなる高度折率薄膜 事を形成でき、この方法には前配した政策が次定による。所望屈折率の無機質酸な、所望屈折率の無機質をといたり安定して形成できることからなる。 反射防止効果と生産性との大幅な改善を図りうる。

(実施例)

以下に、この発明の実施例を記載してより具体 的に説明する。

実施例1

プラスチック透明基材として屈折率 n = 1.69、 厚み100μmのPETフィルムを用いて、その 一面が蒸着面となるように、巻き取り式電子ビーム型真空蒸着装置内にフィルムロールをセットし、この装置内が8×10 Torrになるように排気したのち、2rO。ペレットをターゲットとして、電子ピーム投入パワー300mA、10kVの真空蒸着により、上記PETフィルム上に第1層として関折率ロ。=20、光学的膜厚d。=6mmの2rO。薄膜を形成した。

つぎに、この第1層の上に、電子ビーム投入パワーを340mA、10kVとした真空落着により、屈折率n。=2.1、光学的腹厚は。=63nmのZrO。環膜からなる第2層を形成した。

さらに、この第2層の上に、SIO: をターゲットとして、電子ピーム投入パワー300mA、10kVの真空蒸篭により、屈折率n: -1.46、光学的湿度 d: -90nmのSIO: 薄膜を第3層として形成した。

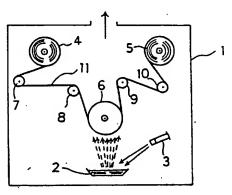
このようにして作製したPBTフィルムを基材とする3階反射防止膜につき、各波長に対応する分光反射率特性を調べたところ、第3図に示され

るとおりであつた。この図から、上記の方法により反射防止効果にすぐれた反射防止膜を安定して 製造しうるものであることがわかる。

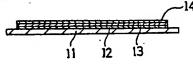
4.図面の簡単な説明

第1図はこの発明の方法に用いる電子ピーム型 真空蒸着装置の一例を示す機略図、第2図はこの 発明の方法により得られる反射防止膜の構成例を 示す断面図、第3図は実施例1の反射防止膜の分 光反射特性を示す特性図である。

1~10…電子ピーム型真空蒸着装置、2… 蒸着材料、3…電子ピーム銃、11…プラス チック透明基材、12…第1層、13…第2 層、14…第3層 第1図



第2日



1~10: 電子ピーム型真空蒸着装置 2: 蒸着材料 3: 電子ピーム銃

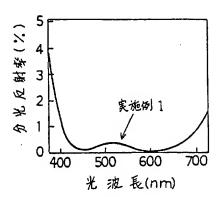
2: 蒸着材料 3:電子ヒーム銃 11: プラスチック透明基材 12: 京1層

13: 第2局

14: 第3局

特許出顧人 日東電工株式会社 代 理 人 弁理士 祢宜元 邦

第3図





THIS PAGE BLANK (USPTO)